



JPW

Docket No. 1232-5268

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Toshihiko TSUJI Group Art Unit: 2873
Serial No.: 10/768,896 Examiner: TBD
Filed: January 29, 2004 Confirmation No. 7295
For: ILLUMINATION OPTICAL SYSTEM AND EXPOSURE APPARATUS

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. §1.8(A))

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

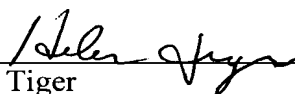
I hereby certify that the attached:

1. Claim to Convention Priority
2. Certified Priority document - Japanese Patent Application
Serial No. 2003-324639, filed September 17, 2003
3. Change of Correspondence Address
4. Return receipt postcard

along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Respectfully submitted,
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: July 20, 2004

By: 
Helen Tiger

Correspondence Address:
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0053
(212) 758-4800 Telephone
(212) 751-6849 Facsimile



Docket No.: 1232-5268

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Toshihiko TSUJI Group Art Unit: 2873
Serial No.: 10/768,896 Examiner: TBD
Filed: January 29, 2004 Confirmation No. 7295
For: ILLUMINATION OPTICAL SYSTEM AND EXPOSURE APPARATUS

CLAIM TO CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in: Japan
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Serial No(s): 2003-324639
Filing Date(s): September 17, 2003

- ☒ Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) a duly certified copy of said foreign application.
- ☐ A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No. _____, filed _____.

Respectfully submitted,
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: July 20, 2004

By: _____

Joseph A. Calvaruso
Registration No. 28,287

Correspondence Address:
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0053
(212) 758-4800 Telephone
(212) 751-6849 Facsimile

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年 9月17日
Date of Application:

出願番号 特願2003-324639
Application Number:
[JP2003-324639]
ST. 10/C]:

願人 キヤノン株式会社
Applicant(s):

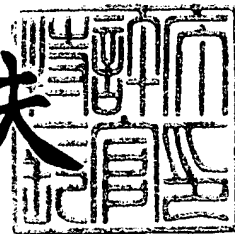
BEST AVAILABLE COPY

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 1月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 257139
【提出日】 平成15年 9月17日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 21/027
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社内
 【氏名】 辻 俊彦
【特許出願人】
 【識別番号】 000001007
 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 【氏名又は名称】 キャノン株式会社
 【代表者】 御手洗 富士夫
【代理人】
 【識別番号】 100090538
 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社内
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 西山 恵三
 【電話番号】 03-3758-2111
【選任した代理人】
 【識別番号】 100096965
 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社内
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 内尾 裕一
 【電話番号】 03-3758-2111
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 011224
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9908388

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

光源からの光で反射型マスクを照明する照明光学系と、該反射型マスクのパターンを基板に投影する投影光学系とを有する露光装置において、

前記照明光学系は、前記反射型マスクの照明領域を規定する視野絞りと、該視野絞りの開口からの光を前記反射型マスクに導く結像系とを有し、

前記結像系は、共軸光学系であり、

前記結像系の前記反射型マスク側の主光線は、該共軸に対して傾斜角を持ち、

該傾斜角は、前記投影光学系の前記反射型マスク側の主光線と前記反射型マスク表面の法線とがなす角と略等しいことを特徴とする露光装置。

【請求項 2】

前記照明光学系は、前記結像系からの光を反射して前記反射型マスクへと導く平面ミラーを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 3】

前記結像系の前記視野絞り側の主光線は、前記共軸と略平行であることを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 4】

前記照明光学系は、前記結像系の瞳面近傍に配置された開口絞りを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 5】

前記照明光学系は、前記開口絞りの開口の大きさ又は形状を変更する機構を有することを特徴とする請求項 4 記載の露光装置。

【請求項 6】

前記視野絞りは、複数の遮光板を持つマスキングブレードを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 7】

前記視野絞りは、円弧形状の開口を持つ円弧スリットを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 8】

前記円弧の曲率中心は、前記共軸上又はその近傍にあることを特徴とする請求項 7 記載の露光装置。

【請求項 9】

前記視野絞りは、複数の遮光板を持つマスキングブレードと円弧形状の開口を持つ円弧スリットとを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 10】

前記照明光学系は、前記光源からの光で複数の 2 次光源を形成する反射型インテグレータと、該複数の 2 次光源からの光束を前記視野絞りに重ねて円弧形状の照明領域を形成するミラー系とを有し、

該円弧の曲率中心は、前記共軸近傍にあることを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 11】

前記結像系は、4 枚のミラーを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 12】

前記 4 枚のミラーのうち前記視野絞りから 1 枚目のミラーと 4 枚目のミラーの反射面は、凹面であることを特徴とする請求項 11 記載の露光装置。

【請求項 13】

前記 4 枚のミラーのうち前記視野絞りから 3 枚目のミラーの反射面は、凸面であることを特徴とする請求項 12 記載の露光装置。

【請求項 14】

前記 4 枚のミラーのうち前記視野絞りから 2 枚目のミラーの反射面は、凹面であることを特徴とする請求項 13 記載の露光装置。

【請求項 1 5】

前記結像系は、その瞳面の近傍に反射面を持つミラーを有することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 1 6】

前記光源からの光は、2 0 0 n m 以下の波長の光であることを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 1 7】

前記光源からの光は、2 0 n m ～ 5 n m の波長の光であることを特徴とする請求項 1 6 記載の露光装置。

【請求項 1 8】

請求項 1 ～ 1 7 のいずれか一項記載の露光装置を用いて基板を露光する工程と、該露光された基板を現像する工程とを有することを特徴とするデバイス製造方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 露光装置

【技術分野】

【0001】

本発明は露光装置に関し、特に光源として波長200nm～10nmの極端紫外線領域(EUV)又はX線領域の発光光源を利用し、半導体ウエハ用の単結晶基板、液晶ディスプレイ用のガラス基板などの被処理体を露光する露光装置に関する。

【背景技術】

【0002】

微細パターンをもつ半導体回路素子などを製造する方法として、例えばEUV光又はX線を用いた縮小投影露光方法がある(例えば、特許文献1～3参照。)

【0003】

この方法では、回路パターンが形成されたマスク(レチクル)をそのEUV光で照明し、マスク上のパターンの像をウエハ面に縮小投影し、その表面のレジストを露光してパターンを転写する。

【0004】

従来のEUV縮小投影露光装置1000の要部概略を図12に示す。図12において、1001はEUV光の発光点、1002はEUV光束、1003はフィルタ、1004は第1の回転放物面ミラー、1005は反射型インテグレータ、1006は第2の回転放物面ミラー、1007は反射型マスク、1008は投影光学系を構成する複数のミラー系、1009はウエハ、1010はマスクステージ、1011はウエハステージ、1012は円弧状アパーチャ、1013はレーザ光源、1014はレーザ集光光学系、1017は真空容器である。また図14は、マスク1007上の照明領域1015と露光が行なわれる円弧状領域1016との関係を示す平面図である。

【0005】

このように露光装置1000は、EUV光を生成する光源部1013および1014、照明光学系(即ち、第1の回転放物面ミラー1004、反射型インテグレータ1005及び第2の回転放物面ミラー1006)、反射型マスク1007、投影光学系1008、ウエハ1009、マスクを搭載したステージ1010、ウエハを搭載したステージ1011、マスクやウエハの位置を精密に合わせる不図示のアライメント機構、EUV光の減衰を防ぐために光学系全体を真空に保つための真空容器1017と不図示の排気装置からなる。

【0006】

照明光学系は、発光点1001からのEUV光1002を第1の回転放物面ミラー1004で集光し、反射型インテグレータ1005に照射して2次光源を形成し、さらに、この2次光源からのEUV光を第2の回転放物面ミラー1006で重畳されるように集光し、マスク1007を均一に照明する。

【0007】

反射型マスク1007は多層膜反射鏡の上にEUV吸収体などからなる非反射部を設けた転写パターンが形成されたものである。反射型マスク1007で反射された回路パターンの情報を有するEUV光は、投影光学系1008によってウエハ1009面上に結像する。

【0008】

投影光学系1008は光軸中心に対して軸外の細い円弧状の領域が良好な結像性能をもつように設計されている。従って、露光はこの細い円弧状領域のみが利用されるように、ウエハ1009直前に円弧状の開口をもったアパーチャ1012が設けられている。そして矩形状をしたマスク全面のパターンを転写するため、反射型マスク1007とウエハ1009が同時にスキャンして露光が行なわれる。

【0009】

ここで投影光学系1008は複数の多層膜反射鏡によって構成され、マスク1007上

のパターンをウエハ1009表面に縮小投影する構成となっており、通常、像側テレセントリック系が用いられている。なお、物体側（反射型マスク側）は、反射型マスク1007に入射する照明光束との物理的干渉を避けるために、通常、非テレセントリックな構成となっている。

【0010】

レーザ光源1013からのレーザ光はレーザ集光光学系1014により発光点1001の位置にある不図示のターゲットに集光され、高温のプラズマ光源1001を生成する。このプラズマ光源から熱輻射により放射されたEUV光1002は第1の回転放物面ミラー1004で反射して平行なEUV光束となる。この光束が反射型インテグレータ1005で反射して、多数の2次光源を形成する。

【0011】

この2次光源からのEUV光は第2の回転放物面ミラー1006で反射して反射型マスク1007を照明する。ここで該2次光源から第2の回転放物面ミラー1006、第2の回転放物面ミラー1006から反射型マスク1007までの距離は、第2の回転放物面ミラー1006の焦点距離に等しく設定されている。

【0012】

2次光源の位置に第2の回転放物面ミラー1006の焦点が位置しているので2次光源の1つから出たEUV光は反射型マスク1007を平行光束で照射する。投影光学系1008は2次光源の像が投影光学系1008の入射瞳面に投影される様に設計されており、これによりケーラー照明の条件が満たされている。即ち反射型マスク1007上のある1点を照明するEUV光は全ての2次光源から出たEUV光の重なったものである。

【0013】

マスク面上の照明領域1015は、図13に示すように、反射型インテグレータ1005の構成要素である凸又は凹面ミラーの反射面の平面形状と相似であり、実際に露光が行なわれる円弧領域1016を含むほぼ矩形領域である。投影光学系1008は2次光源の像が投影光学系1008の瞳面に投影されるように設計されている。

【特許文献1】特開平10-70058号公報

【特許文献2】特開2003-045774号公報

【特許文献3】特開2003-045784号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

しかしながら、従来のEUV縮小投影露光装置には次の様な欠点があった。即ち、ウエハ1009の近傍に照明領域を規定するアパーチャ1012を設けているが、露光時に駆動するウエハからはアパーチャをある程度離さなければならず、露光領域がボケてしまう。

【0015】

また、反射型マスク1007の近傍に同様のアパーチャを設けることも考えられるが、同様の問題が生じる。更に、反射型マスク1007の近傍に同様のアパーチャを設ける場合には、反射型マスクに入射する光と反射型マスクから反射する光の両方を考慮しなければならないため、更に問題が深刻である。

【0016】

更に、照明領域を規定するアパーチャとレチクルとの間に結像系を設けることも考えられるが、従来はその詳細な構成が明らかとされていなかった。

【0017】

そこで、上記従来技術の問題点に鑑み、本発明の例示的な目的は、照明領域を規定するアパーチャとレチクルとの間の結像系の好適な構成を明らかにするとともに、その結像系を有する照明光学系を用いた露光装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0018】

上記目的を達成するために、本発明の一側面としての露光装置は、光源からの光で反射型マスクを照明する照明光学系と、該反射型マスクのパターンを基板に投影する投影光学系とを有する露光装置において、前記照明光学系は、前記反射型マスクの照明領域を規定する視野絞りと、該視野絞りの開口からの光を前記反射型マスクに導く結像系とを有し、前記結像系は、共軸光学系であり、前記結像系の前記反射型マスク側の主光線は、該共軸に対して傾斜角を持ち、該傾斜角は、前記投影光学系の前記反射型マスク側の主光線と前記反射型マスクの表面の法線とがなす角に略等しいことを特徴とする。

【0019】

本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下、添付の図面を参照して説明される好ましい実施例等によって明らかにされるであろう。

【発明の効果】

【0020】

従来よりも、性能の良い露光装置を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

以下に、本発明の実施の形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。

【実施例1】

【0022】

図1は本発明の第1の実施例の要部概略図である。同図において、1は励起レーザ光、2はEUV光を放射するプラズマ発光点、3aはプラズマ生成のターゲットとなる液滴を噴射するノズル、3bは励起レーザ光が照射されなかった液滴を回収して再利用するための液滴回収部、4はプラズマ発光点から放射される光束を受光する集光ミラー、6aはプラズマからの飛散粒子（デブリ）を除去するフィルタ、6bはEUV光以外の波長の光束を除去する波長フィルタ、7は集光ミラー4の集光点近傍に配置されたピンホール状の آپァーチャ、8はプラズマ光源を収容する真空容器、であり、これらが光源部を構成している。なお、5はミラー4により集光されたEUV光束であり、9は露光装置本体とプラズマ光源部を真空状態で接続するための接続部である。

【0023】

次に、10a、10bはアパーチャ7を通過したEUV光束を受光し、ほぼ平行光束に変換するための凹面ミラーと凸面ミラーからなる平行変換光学系である。11aは複数の円筒面ミラーを有するインテグレート、11b、11cはインテグレート11aからの光束を円弧状に集光するための回転放物面ミラーを含んだ光学系である。11a、11b、11cで円弧変換光学系を形成している。12、13はスリット系（視野絞り）を構成しており、12は円弧状の開口部を有し、その幅を部分的に可変できるスリット、13は反射型マスク16と共役な面に配置され、所望の露光領域に照明光を制限するためのマスキングブレードである。14はマスキング結像系であって、マスキングブレード13を物体側、反射マスク16面を像側として所望の倍率で結像し、円弧照明領域を反射マスク上に形成する。14a、14b、14c、14dは光学系でありマスキング結像系14を構成する曲面ミラー、14eは結像系14a～14dからの光束を反射してマスキング結像系14の像側光束14'を反射マスク16へはね上げて所定の角度で入射させるための平面ミラー、15は結像系14a～14dの瞳面に配置された開口絞りであり、以上が、光源部からの光で反射マスク16を照明する照明光学系を構成する。

【0024】

そして、17は反射マスク16を保持するマスクステージ、18は複数枚のミラーにより構成される投影光学系であり共軸光学系となっており物体側が非テレセンで像側がテレセンになるように設計されている。19は感光材が塗布されたウエハ、20はウエハ19を保持するウエハステージ、21はEUV光の減衰を防ぐために光学系全体を真空に保つための真空容器である。

【0025】

不図示の励起レーザ光源及び集光光学系から成る励起レーザ部から放射された、高出力

の励起パルスレーザー光 1 は、発光点 2 の位置に集光するように構成されており、レーザープラズマ光源部を形成している。このレーザープラズマ光源のターゲットとなる液滴（例えば Xe から成る）は、ノズル 3 a から一定の時間間隔で連続的に噴射され、集光点 2 を通過するようになっている。そして上記のように噴射された液滴が、ちょうど 2 の位置にきた時に、励起パルスレーザー光 1 がその液滴を照射することで高温のプラズマ発光点 2 を生成し、このプラズマからの熱輻射によって E U V 光が発生する。

【0026】

なお、本実施例ではターゲットとして Xe の液滴を用いた形態を示しているが、ターゲットとしては Xe ガスをノズルから真空中に噴射して、断熱膨張により生じるクラスタを用いたり、Xe ガスを金属表面で冷却して固体化したものを用いたり、Cu 等の金属テープを用いたものを選択してもよい。あるいは、E U V 光源としてアンジュレータを用いてもよい。また、E U V 光源として Z ピンチ方式、プラズマ・フォーカス、キャピラリー・ディスチャージ等の所謂ディスチャージ方式によるプラズマ光源を用いてもよい。

【0027】

プラズマ発光点 2 から放射された E U V 光は、回転楕円ミラー等による集光ミラー 4 により集光されて E U V 光束として取りだされ、フィルタ 6 a によりプラズマ及びその周辺から直接前方へ飛ぶ飛散粒子（デブリ）を除去され、さらに必要に応じてフィルタ 6 b により E U V 露光に不要な波長成分を除去されて、プラズマ光源を収容する真空容器 8 と、露光装置本体の真空容器 21 の境界面に設けられたピンホール状のアパーチャ 7 の位置に集光される。光源の真空容器 8 と露光装置本体の真空容器 21 は、接続部 9 で接続されている。

【0028】

上記アパーチャ 7 を通過した E U V 光束 5 は、中心部分に開口部を有する凹面ミラー 10 a とそのミラーと比べて比較的小径の凸面ミラー 10 b からなる平行変換光学系によりほぼ平行な光束 10' に変換される。ここで、凹面ミラー 10 a は凸面ミラー 10 b によって反射された光が通過するための開口を有し、その開口は光源からの E U V 光束の光軸近傍に配置されている。また、これらのミラー 10 a, 10 b は、光源からの E U V 光束の光軸に対して、略回転対称となるような反射面を有しており、中心軸とその E U V 光束の光軸とがほぼ一致している。

【0029】

ここで上記の集光ミラー 4 及びミラー 10 a, 10 b は、E U V 光を効率良く反射するための反射多層膜が成膜されており、高温のプラズマ 2 からの放射エネルギーを一部吸収するために、露光中に高温になる。そのために材質としては熱伝導性の高い金属等の材料を用いるとともに、水冷など不図示の冷却手段を有しており、露光中は常に冷却されている。

【0030】

また、以下では特に明示しないが、光学系に用いられている各ミラーの反射面には、E U V 光を効率良く反射するための反射多層膜が成膜されており、必要に応じてミラーは熱伝導性の高い金属等の材料を用いたり、冷却手段を装備したりしている。

【0031】

次に、ほぼ平行な光束に変換された E U V 光 10' は、複数の反射型円筒面ミラーを有するインテグレータ 11 a に入射し、各円筒面により分割されて発散する光束が、平面ミラー 11 b と回転放物面ミラー 11 c により円弧状に集光される事で、円弧スリット 12 の開口部に均一な照度分布をもつ円弧照明領域を形成する。

【0032】

ここで、インテグレータ 11 a によって円弧領域を均一に照明する原理について、別の図を用いて詳細に説明する。

【0033】

図 3 (a) は複数の凸円筒面をもった反射型凸円筒面インテグレータ 11 a に平行光が入射した場合の模式的斜視図であって、前記のほぼ平行な E U V 光束 10' は図示した方

向から入射する。また図3 (b) は、図3 (a) と同様の効果を有する複数の凹円筒面をもった反射型凹円筒面インテグレータの模式的斜視図である。図1のインテグレータ11aは、図3 (a) で示されるような反射型凸円筒面インテグレータであるが、図3 (b) で示されるような反射型凹円筒面インテグレータでも、あるいはこれらの凹凸の組み合わせであっても良い。

【0034】

図4は反射型凸円筒面インテグレータの模式的断面図、図5は反射型凸円筒面インテグレータの円筒面でのEUV光反射の説明図、図6は反射型凸円筒面インテグレータの円筒面で反射したEUV光束の角度分布図である。各図中、符号11aは反射型凸円筒面インテグレータを示している。

【0035】

図3 (a) の様に、複数の円筒面をもったインテグレータ11aにはほぼ平行なEUV光束11を入射すると、このインテグレータの表面近傍に線状の2次光源が形成されると共に、この2次光源から放射されるEUV光束の角度分布が円錐面状となる。次にこの2次光源位置を焦点とする反射鏡で前記EUV光束を反射して反射マスクあるいは反射マスクと共役な面を照明することにより、円弧形状の照明が可能となる。

【0036】

複数の円筒面をもった反射型インテグレータの作用を説明するために、まず、一つの円筒面反射鏡に平行光が入射した場合の反射光の振る舞いについて図5を用いて述べる。今、一つの円筒面にその中心軸に垂直な面に対して θ の角度で平行光を入射する場合を考える。平行な入射光の光線ベクトルを

$$P1 = (0, -\cos \theta, \sin \theta)$$

円筒面形状の反射面の法線ベクトルを

$$n = (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$$

とすると、反射光の光線ベクトルは

$$P2 = (-\cos \theta \times \sin 2\alpha, \cos \theta \times \cos 2\alpha, \sin \theta)$$

となる。このとき反射光の光線ベクトルを位相空間にプロットすれば、図6に示すようにxy平面上で半径 $\cos \theta$ の円となる。即ち、反射光は円錐面状の発散光となり、この円錐面の頂点の近傍に2次光源が存在することになる。この2次光源はインテグレータ11aの円筒面が凹面であれば反射面の外部に実像として存在し、凸面であれば反射面の内部に、虚像として存在することになる。また図4に示すように反射面が円筒面の一部に限られていて、その中心角が 2ϕ である場合は、図6に示すように反射光の光線ベクトルP2の存在範囲はxy平面上で中心角 4ϕ の円弧601となる。

【0037】

次に、上述した円筒面反射鏡に平行光が入射して形成される2次光源の位置近傍に焦点をもつ、焦点距離 f の回転放物面ミラーと、さらにこの反射鏡から f だけ離れた位置に被照射面を配置した場合を考える。2次光源から出た光は円錐面状の発散光になり焦点距離 f の反射鏡で反射したのち、平行光となる。このときの反射光は半径 $f \times \cos \theta$ で中心角 4ϕ の円弧状断面のシートビームになる。従って図6で示した様に、被照射面上の半径 $f \times \cos \theta$ で中心角 4ϕ の円弧状領域601のみが照明されることになる。

【0038】

これまでは1つの円筒面反射鏡について説明してきたが、次に、多数の円筒面を平行に多数並べた広い面積のインテグレータ11aに、ある光束径を有する平行光10'が図1に示した方向に入射した場合について、図2を用いて説明する。

【0039】

図2において、11aは前述したインテグレータ、11bは平面ミラー、11cは回転放物面ミラー、12は円弧状の開口部を有するスリットである。回転放物面ミラー11cは、軸201AXを中心対称軸とし、点202を焦点とする放物線を、軸201AXを回転軸として回転させて形成される面の一部を反射面とするミラーであって、焦点202とミラー面有効部中心点204との距離が、焦点距離 f となる。また、点204と円弧スリ

ット12の距離は、ほぼ前述の焦点距離 f に等しくなるように配置されている。

【0040】

そして回転放物面ミラー11cは、その回転軸201AXがインテグレータ11aの反射面近傍（反射面含む）に、反射面と平行かつ表面の円筒面の並びに沿うように配置されている。そして回転放物面ミラー11cの有効部中心点204と焦点202の間には、平面ミラー11bが図に示すように配置されており、焦点202のミラー11b反射面に対して対称な点202'が、インテグレータ11aの反射面有効部のほぼ中心位置にくるような構成となっている。即ち、位置204から位置202'への光路長が焦点距離 f に等しい。

【0041】

このような配置にした場合、位置202'と円弧スリット12は、回転放物面ミラー11bに対して互いに焦点距離 f だけ離れた関係、即ち互いにはほぼフーリエ変換面の関係となり、ほぼ平行なEUV光束10'が図のようにインテグレータ11aに入射した場合は、円弧スリット12の開口部近傍に集光される。

【0042】

この時、回転放物面ミラー11cへのEUV光束主光線の入射角 ϵ は低入射角度（ 0° より大きく 45° 以下の角度）、具体的には 20° 以下に設定されており、これにより入射角 ϵ が高入射角となるような配置にするよりも、円弧スリット12への集光の際に生じるボケ量を小さくして、円弧開口部近傍への集光効率を高めることができる。これによりケラレによる光の損失を抑える事が可能となり、照明系効率の向上をもたらすことができる。

【0043】

次に円筒面を平行に多数並べた反射鏡で反射された光の角度分布は、先の例と変わらないので、インテグレータ11aへの光束入射角を ϵ とすると、円弧スリット12の近傍には半径 $f \times \cos \epsilon$ の円弧状領域が照明されることになる。また、円弧スリット12近傍の一点に入射する光は、円筒面を平行に多数並べた反射鏡の照射領域全域から到達するので、ほぼ平行なEUV光束10'の光束径を D とすると、その角度広がり（すなわち集光NA） γ は $\gamma = D/f$ となる。

【0044】

この時、円弧照明領域において、その円弧に沿った方向に対して、インテグレータ11aの多数の円筒面からの各光束が重畳されることで、照度の均一性が達成されている。即ちこれにより効率がよく均一な円弧照明を行なうことが可能となる。

【0045】

ここで図1に戻り、本実施例の露光方法について引き続き説明する。同図において円弧スリット12の開口部近傍に形成された円弧照明領域は、マスキングブレード13によりその領域の一部を制限され、マスキング結像系14により所望の倍率で拡大または縮小されて、マスクステージ17に保持された反射型マスク16上に、所望の入射角度で入射して円弧照明領域を形成することで反射マスク16に対して円弧照明を行なう。なおこの円弧状の照明領域の曲率中心は、投影光学系18の光軸18AXにはほぼ一致している。

【0046】

この円弧照明された反射型マスク16からの回路パターン情報を有するEUV反射光は、投影光学系18により露光に最適な倍率で、感光材が塗布されたウエハ19に投影結像されることで、回路パターンの露光が行なわれる。

【0047】

上記ウエハ19はウエハステージ20に固定されており、紙面上で上下前後に平行移動する機能を持ち、その移動は不図示のレーザ干渉計等の測長器で制御されている。そして、投影光学系18の倍率を M とすると、例えば反射型マスク16を紙面に平行な方向に速度 v で走査すると同時に、ウエハ19を紙面に平行な方向に速度 v/M にて同期走査することで、全面スキャン露光が行なわれる。

【0048】

上記投影光学系 18 は複数の多層膜反射鏡によって構成され、光軸中心 18AX に対し軸外の細い円弧状の領域が良好な結像性能をもつように設計されている。そして反射型マスク 16 上のパターンをウエハ 19 表面に縮小投影する構成となっており、像側（ウエハ側）テレセントリック系となっている。そして物体側（反射型マスク側）は、反射型マスク 16 に入射する照明光束との物理的干渉を避けるために、通常、非テレセントリックな構成となっており、例えば本実施例においては、物体側主光線はマスク 16 の法線方向に対して約 6° 傾いている。

【0049】

以下では、

- ・円弧照明によるスキャン露光について
 - ・円弧スリット 12 による露光ムラ補正方法
 - ・スキャン露光時のマスキングブレード 13 の動作
 - ・マスキング結像系の構成
- について順を追って詳細に説明する。

【0050】

図 7 (a) 及び図 7 (b) は、それぞれウエハ面におけるスキャン露光開始および終了の状態を示す図である。同図において、701 はウエハ面上の円弧照明領域であり、702 は露光対象となる露光領域である。この図では露光領域 702 はウエハステージ駆動により紙面の左から右へ移動し、円弧照明領域 701 が相対的に露光領域 702 を走査するようになっている。露光開始及び終了の段階で、円弧照明領域 701 が露光領域 702 以外の部分を照明しているが、これを防ぐためにマスキングブレードが遮光するようになっている。これについては後のマスキングブレードの動作の説明のところで述べる。

【0051】

なおこの例で示した走査方向に対して、相対的に逆方向に走査して露光を行なう場合についても同様である。

【0052】

上記のスキャン露光において、円弧スリット 12 により露光ムラを補正する方法の詳細について図 8 を用いて説明する。同図において、810 は円弧スリット 12 のスリット幅 811 を部分的に変えるための可動エッジ部が多数並んだものであり、811 は円弧照明領域を形成するためのスリット開口部、812 は前述したインテグレータ 11a 及びミラー系 11b、11c により形成された円弧照射領域であって、この照射領域からスリット開口部 811 を通過する光束を切り出すようになっている。

【0053】

ここでスキャン露光時において、反射型マスク 16 の回路パターンをウエハ 19 に縮小して転写する際に、円弧スリット内に照度ムラがあるとスキャン露光した際に露光ムラが発生する。この問題を解消するために、円弧スリット内で照度が相対的に強い部分のスリット幅のみを、可動エッジ部 810 を不図示の駆動系で動かすことにより少し狭くして、所望の量だけ光量を少し減らしてスキャン露光することで、露光領域全面で積算した結果として均一な強度で露光することが可能となる。

【0054】

またマスキングブレード 13 は、801、802、803、804 の 4 枚の遮光板により構成されており、図 8 において上下の遮光板 803、804 は、円弧スリット開口 811 における円弧照射領域 812 の両端を遮光する事で、図 7 (a) に示した露光領域 702 の上下幅（スキャン幅）を決定している。

【0055】

遮光板 801 及び 802 はスキャン露光においてワンショットの露光開始から終了までの間に、それぞれ左右方向に移動して隙間を開閉する事で、露光領域 702 の左右幅（スキャン長さ）を決定している。これについて図 9 を用いて以下に説明する。

【0056】

図 9 において (a1) から (a5) は、スキャン露光の開始から終了までを時系列に表

現したものであり、(b 1) から (b 5) はそれぞれ (a 1) から (a 5) の状態におけるマスキングブレード 13 の遮光板 801 及び 802 の動きを示したものである。

【0057】

露光が開始されようとしている (a 1) の状態になった時、(b 1) にて遮光板 802 は右に移動を開始して、隙間を開く動作に入る。この時、円弧照明領域 701 は遮光されている状態なので、図示はしてあるが実際には照明はされていない状態である。そして (a 2) に示すようにスキャン露光に入った段階で、円弧照明領域 701 が露光領域 702 からはみ出している部分がちょうど遮光されるように、(b 2) に示すような状態で遮光板 802 が移動していく。さらに (a 3) のように露光領域 702 内に円弧照明領域 701 が入っておりスキャン露光されている時には、(b 3) のように遮光板 802 はスリット開口部 811 が完全に開いた状態になるように右に移動している。次に (a 4) のようにスキャン露光が終了近くなってくると、今度は遮光板 801 が右に移動して、円弧照明領域 701 が露光領域 702 からはみ出している部分がちょうど遮光される。そして (a 5) のようにスキャン露光が完了したときには、遮光板 801 がスリット開口部 811 を完全に覆うように移動している。以上の一連の動作によって、所望の露光領域に対してスキャン露光が行なわれる。

【0058】

次に、マスキング結像系 14 の詳細について図 10 を用いて説明する。マスキング結像系 14 は、前述したマスキングブレード 13 を物体面、反射型マスク 16 (図では位置 102) を像面とし、反射多層膜を成膜したミラーにより構成される結像光学系である。この結像系は共軸光学系であり、共軸 (光軸) 10AX を略中心とする物体側の円弧領域に対して所望の倍率をかけて、投影系 18 に対して好適な円弧照明領域を形成するように結像する機能を有する。

【0059】

同図において、14a、14b、14c、14d はそれぞれ中心軸 10AX を回転対称軸とする、凹面又は凸面の球面または非球面から成るミラーであって、本実施例においては、14a から順番に凹凹凸凸の形状となっている。またマスキング結像系 14 の瞳面はミラー 14b の反射面近傍 (反射面含む) にあり、瞳面の近傍 (瞳面含む) に開口絞り 15 を配置している。この開口絞り 15 の開口パターンを変える事で、開口の大きさ又は形状を変更することができ、つまり、反射マスク側の照明光束の収束角 (いわゆるコヒーレントファクター) を変えたり、変形照明を行ったりすることが可能であるが、詳細は後述する。

【0060】

円弧スリット 12 の近傍に配置したマスキングブレード 13 の位置に集光した EUV 光束は、その主光線が回転対称軸 10AX に対して平行な状態すなわち物体側テレセンで、マスキング結像系 14 に入射する。入射した光束は上述した 4 枚のミラー及び開口絞り 15 を経て、像面 102 へ集光される。この時注意すべきは、像側は非テレセンな構成となっていることであり、主光線 103 の像面 102 への入射角度 101 (主光線 103 と回転対称軸 10AX のなす角度) は、投影系 18 の物体側主光線のマスク面法線に対する傾斜角とほぼ等しくなるように設定されていることである。つまり、反射型マスクの照明領域内の各位置に対応する、結像系 14a ~ d のマスク側主光線と回転対称軸 10AX とのなす角度は、投影光学系のマスク側主光線とマスク面の法線とのなす角度とほぼ等しくなるように設定されている。本実施例の場合、入射角度 101 は約 6° に設定されており、投影光学系 18 のマスク側の対応する主光線とマスク面の法線とのなす角度と等しくなっている。なお、投影光学系の光軸 (共軸) 18AX とマスク面の法線とが平行であることから、投影光学系の光軸 18AX と投影光学系のマスク側の対応する主光線とがなす角度もそれと等しくなっている。従って、結像系のマスク側主光線の結像系の光軸に対する角度は、投影光学系のマスク側主光線とマスク面法線とのなす角と略等しくなっている。なお結像系は、像側のボケについても良好に補正されており、像面でスポット径が 5 mm 以下、望ましくは 1 mm 以下になるように設計されている。

【0061】

図1で示したマスキング結像系14の像側光束14'においては、平面ミラー14eで像側光束を反射マスク16の方向へはね上げた時に、平面ミラー14eによる反射によって光束14'が形成する円弧照明領域の円弧の向きは反転して、且つその円弧の中心は投影系18の中心軸18AXと反射マスク面の交点にほぼ一致している。そして上記で示したように入射角度101を設定することで、上記の光束14'の主光線と投影系18の物体側光束18'の対応する主光線が、反射マスクを反射面として互いにほぼ一致するように配置する事が可能となる。

【0062】

次にマスキング結像系14における開口絞り15の切り替えにより、コヒーレントファクタ σ を変えたり、輪帯照明等の変形照明を行なったりする方法について述べる。開口絞り15（即ちマスキング結像系の瞳面）と投影系18の瞳面は、互いに共役な関係にあるので、開口絞り15の開口パターンつまり光束の透過パターンが、投影系瞳面における光源像即ち有効光源分布と対応している。図11は、開口絞り15が有する開口部の形状の例を示す図であり、(a)は通常照明の大 σ 、(b)は通常照明の小 σ 、(c)は輪帯照明、(d)は四重極照明の各モードに対応している。

【0063】

このようないくつかの開口パターンを例えばターレットとして用意しておき、不図示の開口絞り駆動系によりこのターレットを回転させることで、所望の開口形状に切り替えることが可能である。また、ターレットを用いずに他の機械的な方法、例えば複数の開口絞りを並べておいて、順次切り替えてももちろん構わないし、虹彩絞りを使用してももちろん良い。

【実施例2】

【0064】

次に、実施例1の露光装置を利用したデバイスの製造方法の実施例を説明する。図15はデバイス（ICやLSI等の半導体チップ、液晶パネルやCCD）の製造フローを示す。ステップ1（回路設計）では半導体デバイスの回路設計を行なう。ステップ2（マスク製作）では設計した回路パターンを形成したマスク（レチクル）を製作する。一方、ステップ3（ウエハ製造）ではシリコン等の材料を用いて基板（被処理体）としてのウエハを製造する。ステップ4（ウエハプロセス）は前工程と呼ばれ、上記用意したマスクとウエハとを用いて、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップ5（組み立て）は後工程と呼ばれ、ステップ4によって作成されたウエハを用いてチップ化する工程であり、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チップ封入）等の工程を含む。ステップ6（検査）ではステップ5で作成された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行なう。こうした工程を経て半導体デバイスが完成し、これが出荷（ステップ7）される。

【0065】

図16は上記ウエハプロセスの詳細なフローを示す。ステップ11（酸化）ではウエハの表面を酸化させる。ステップ12ではウエハの表面に絶縁膜を形成する。ステップ13（電極形成）ではウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ14（イオン打ち込み）ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ15（レジスト処理）ではウエハにレジスト（感材）を塗布する。ステップ16（露光）では実施例1の露光装置によってマスクの回路パターンの像でウエハを露光する。ステップ17（現像）では露光したウエハを現像する。ステップ18（エッチング）では現像したレジスト以外の部分を削り取る。ステップ19（レジスト剥離）ではエッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。これらステップを繰り返し行なうことによりウエハ上に回路パターンが形成される。

【0066】

本実施例の製造方法を用いれば、従来は難しかった高集積度のデバイスを製造することが可能になる。

【0067】

以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、本実施形態では13.5 nmのEUV光を用いる照明系について説明したが、本発明はその他の光（例えば、波長200 nm～10 nmの極端紫外線領域（EUV）又はX線領域の光）を用いる照明光学系にも適用することができる。なお、20～5 nmの光に対しては、レンズとして使用できる硝材は存在せず光学系をミラーで構成する必要があるため、その領域の光を用いる照明光学系に本発明を適用するとより有効である。

【図面の簡単な説明】

【0068】

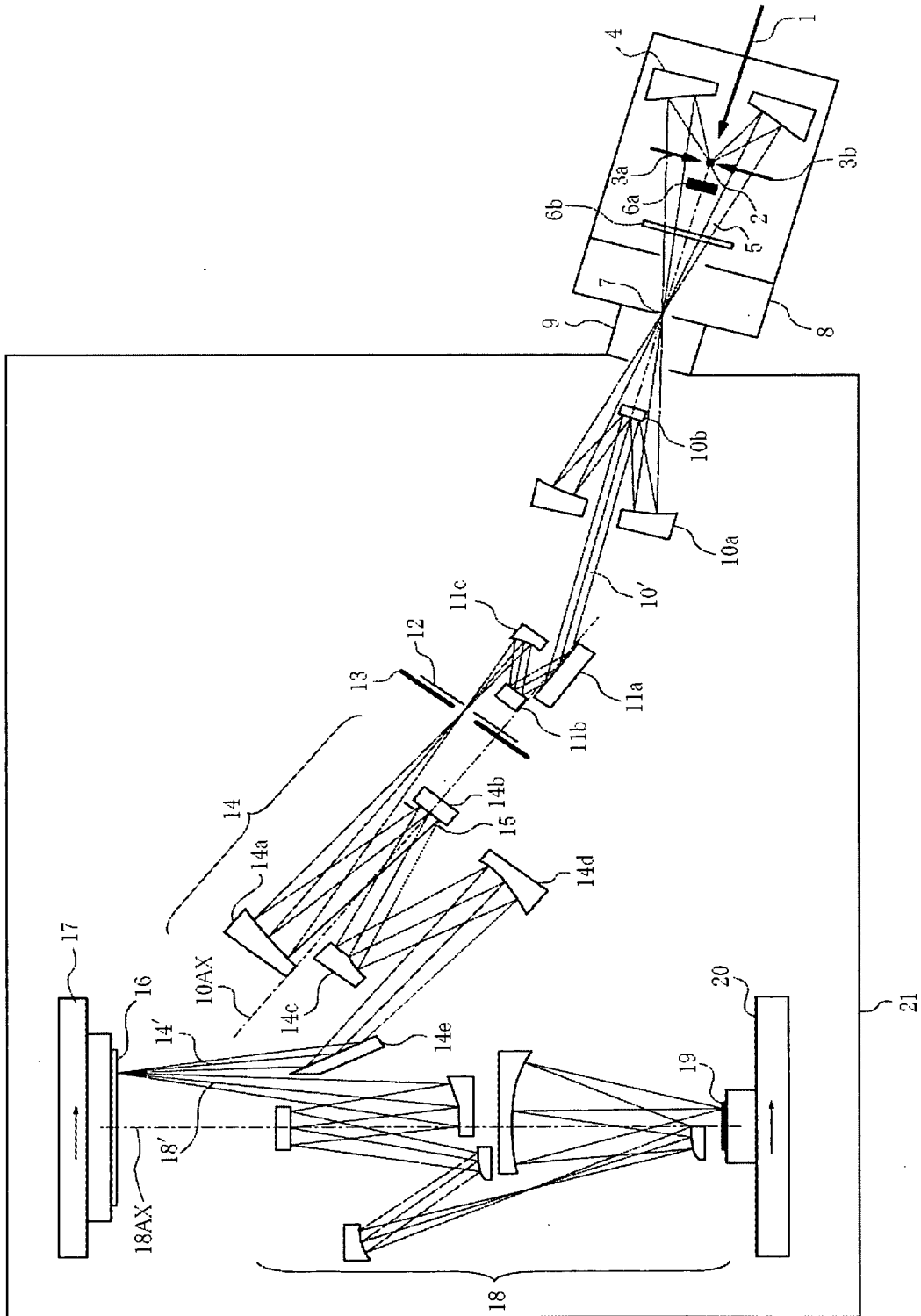
- 【図1】 本発明の実施例の概略図である。
- 【図2】 インテグレートに平行光束が入射した場合について説明する図である。
- 【図3】 インテグレートの概略図である。
- 【図4】 インテグレートの断面形状を示す図である。
- 【図5】 円筒面で反射した光束の角度分布を説明する図である。
- 【図6】 円筒面で反射した光束により円弧領域が形成されることを示す図である。
- 【図7】 スキャン露光の動作を示す図である。
- 【図8】 可変円弧スリット及びマスキングブレードの概略図である。
- 【図9】 スキャン露光中のマスキングブレードの動作を示す図である。
- 【図10】 マスキング結像系の概略図である。
- 【図11】 照明モードの切り替えを説明する図である。
- 【図12】 従来例を表す要部概略図である。
- 【図13】 従来の反射型インテグレートの模式的斜視図である。
- 【図14】 従来の照明領域と露光に使用される円弧領域を示す図である。
- 【図15】 デバイスの製造フローを示す図である。
- 【図16】 図15中のウエハプロセスを示す図である。

【符号の説明】

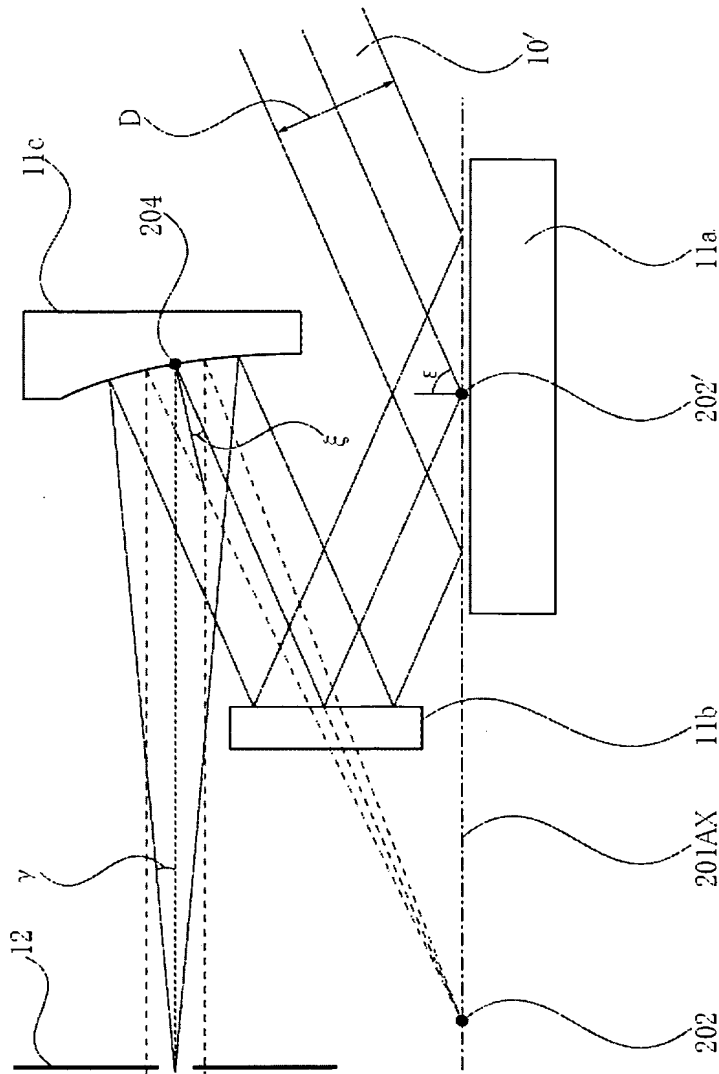
【0069】

- 1 励起レーザ光
- 2 プラズマ発光点
- 4 集光ミラー
- 8 真空容器
- 10a 平行変換光学系
- 10b 平行変換光学系
- 11a インテグレート
- 12 可変円弧スリット
- 13 マスキングブレード
- 14 マスキング結像系
- 15 開口絞り
- 16 反射型マスク
- 17 マスクステージ
- 18 投影光学系
- 19 ウエハ
- 20 ウエハステージ
- 21 真空容器

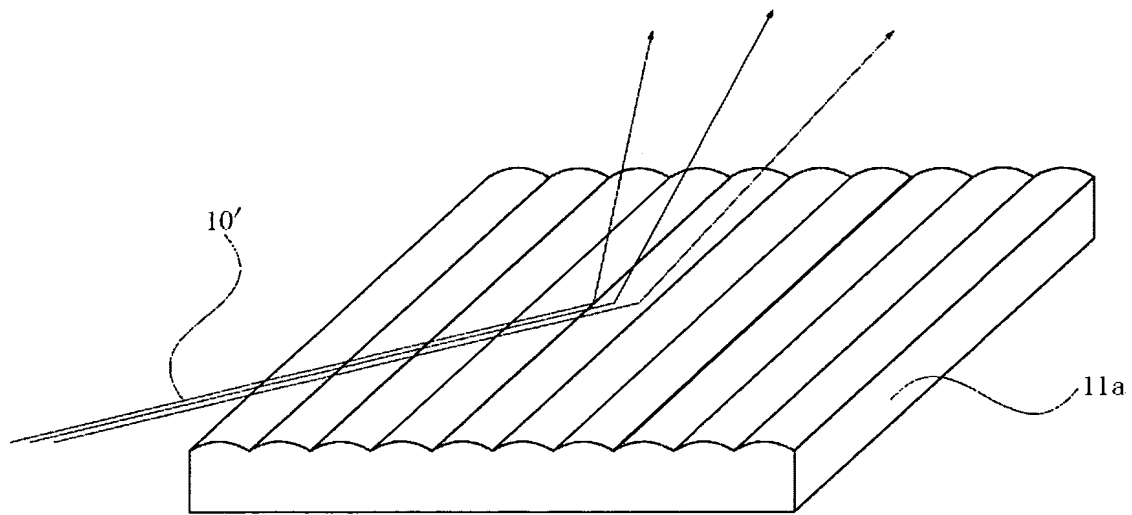
【書類名】 図面
【図 1】



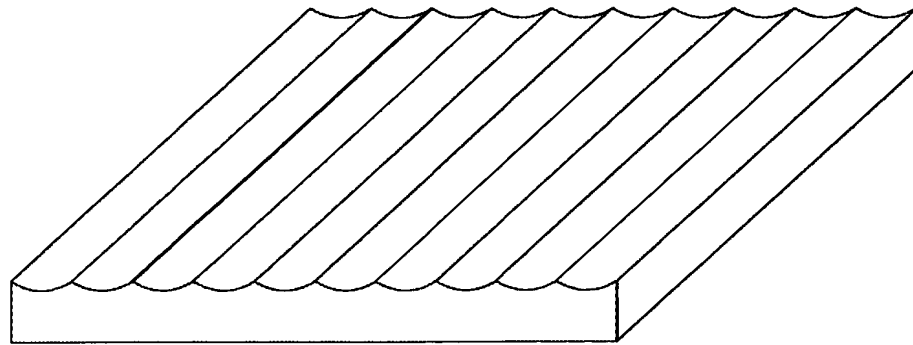
【図 2】



【図 3】

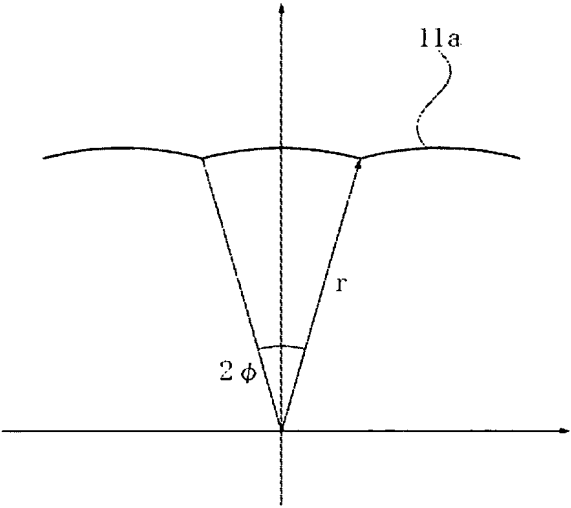


(a)

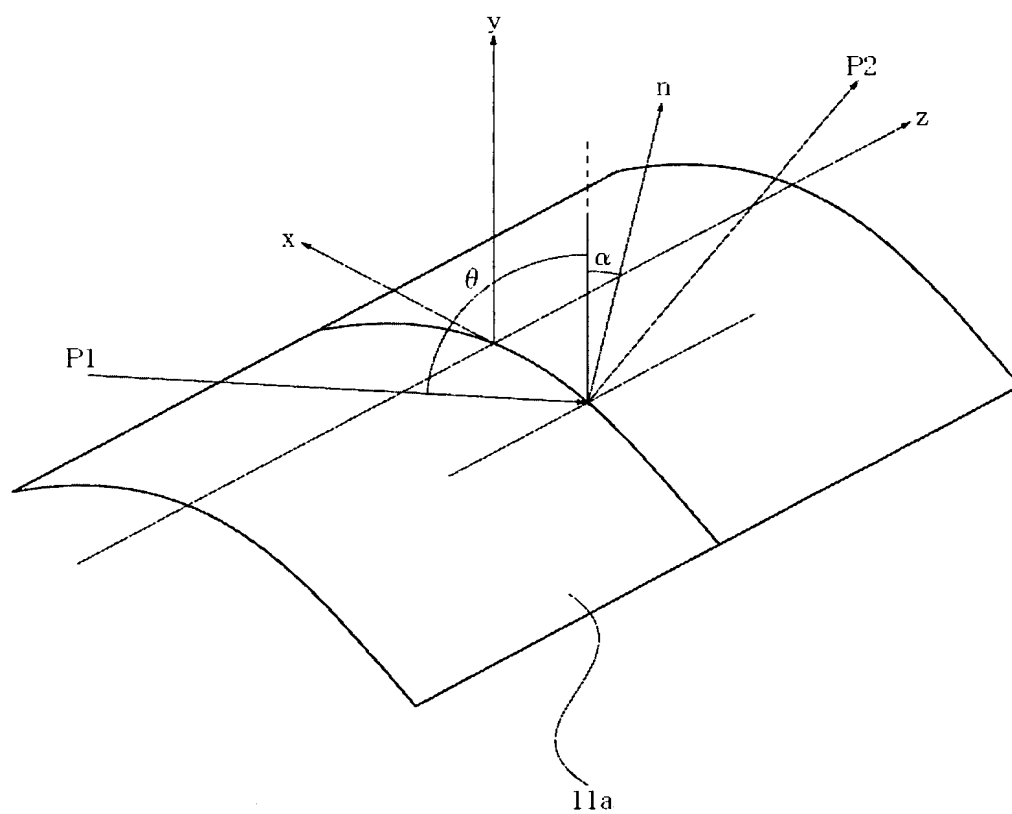


(b)

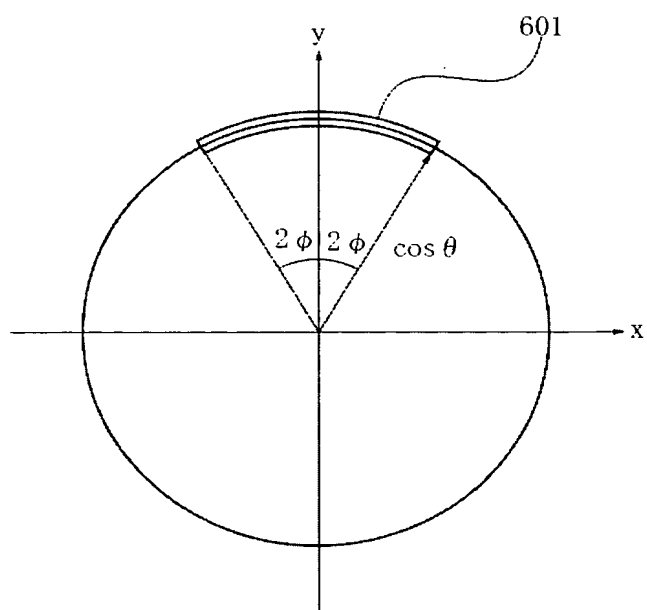
【図 4】



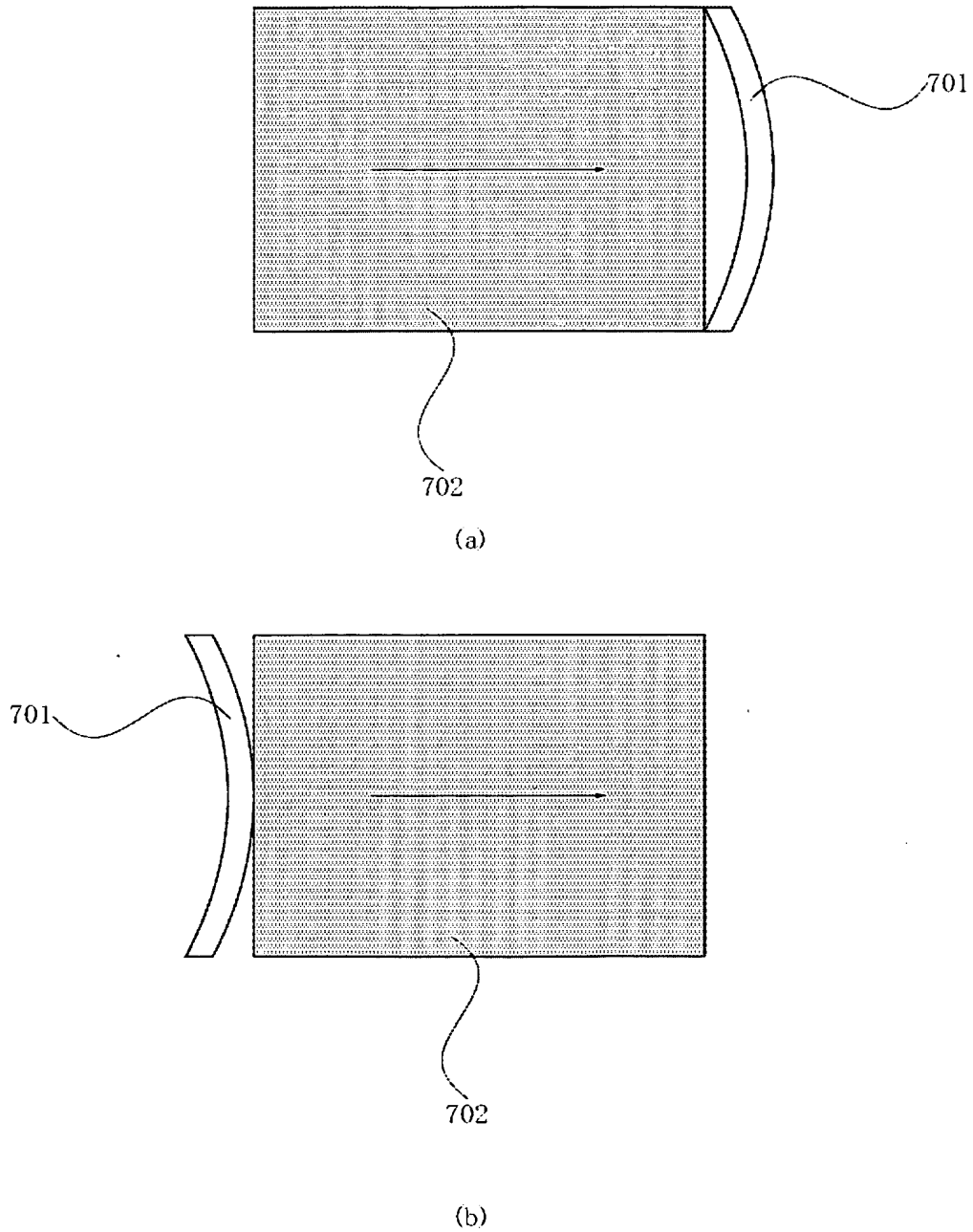
【図 5】



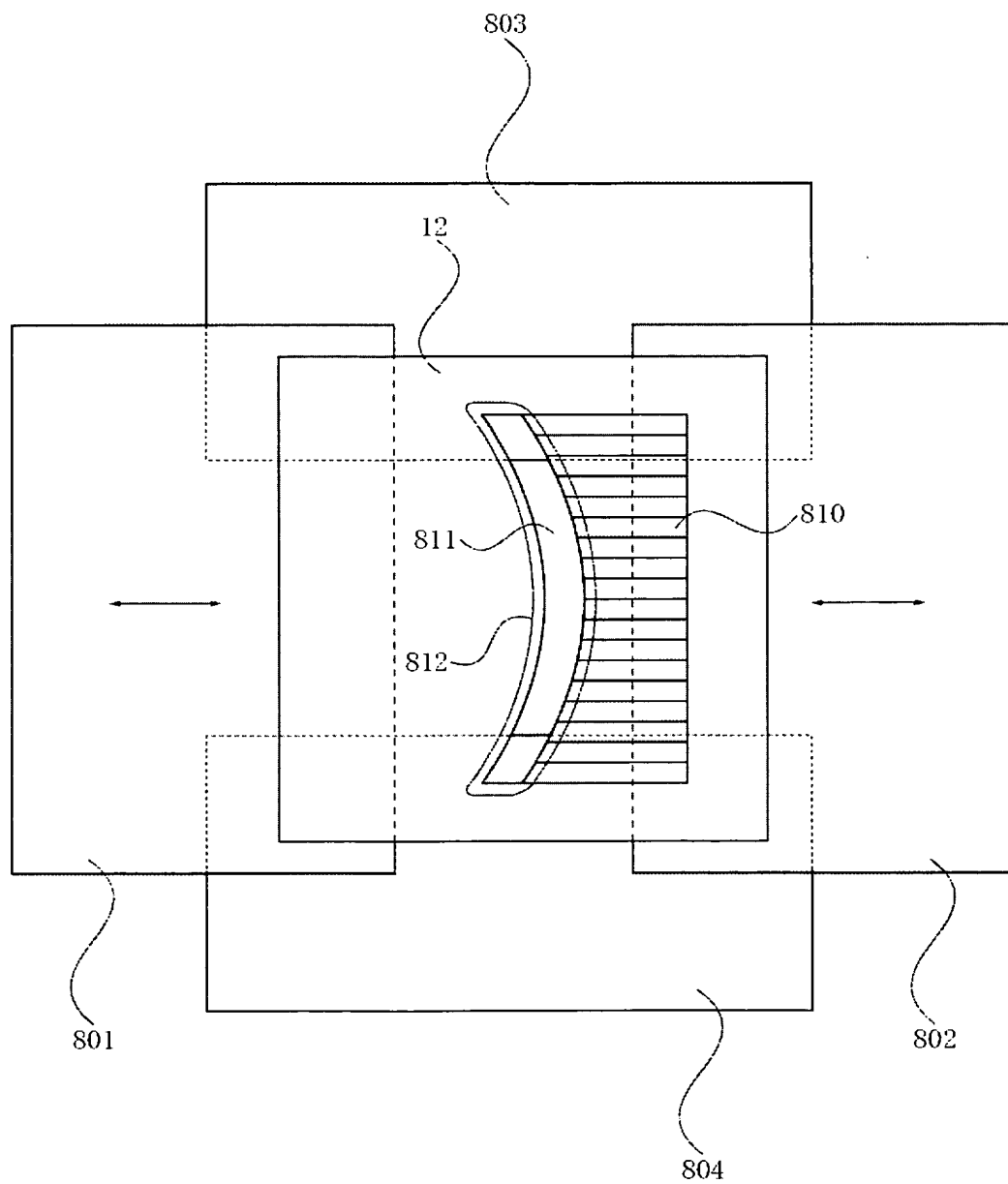
【図 6】



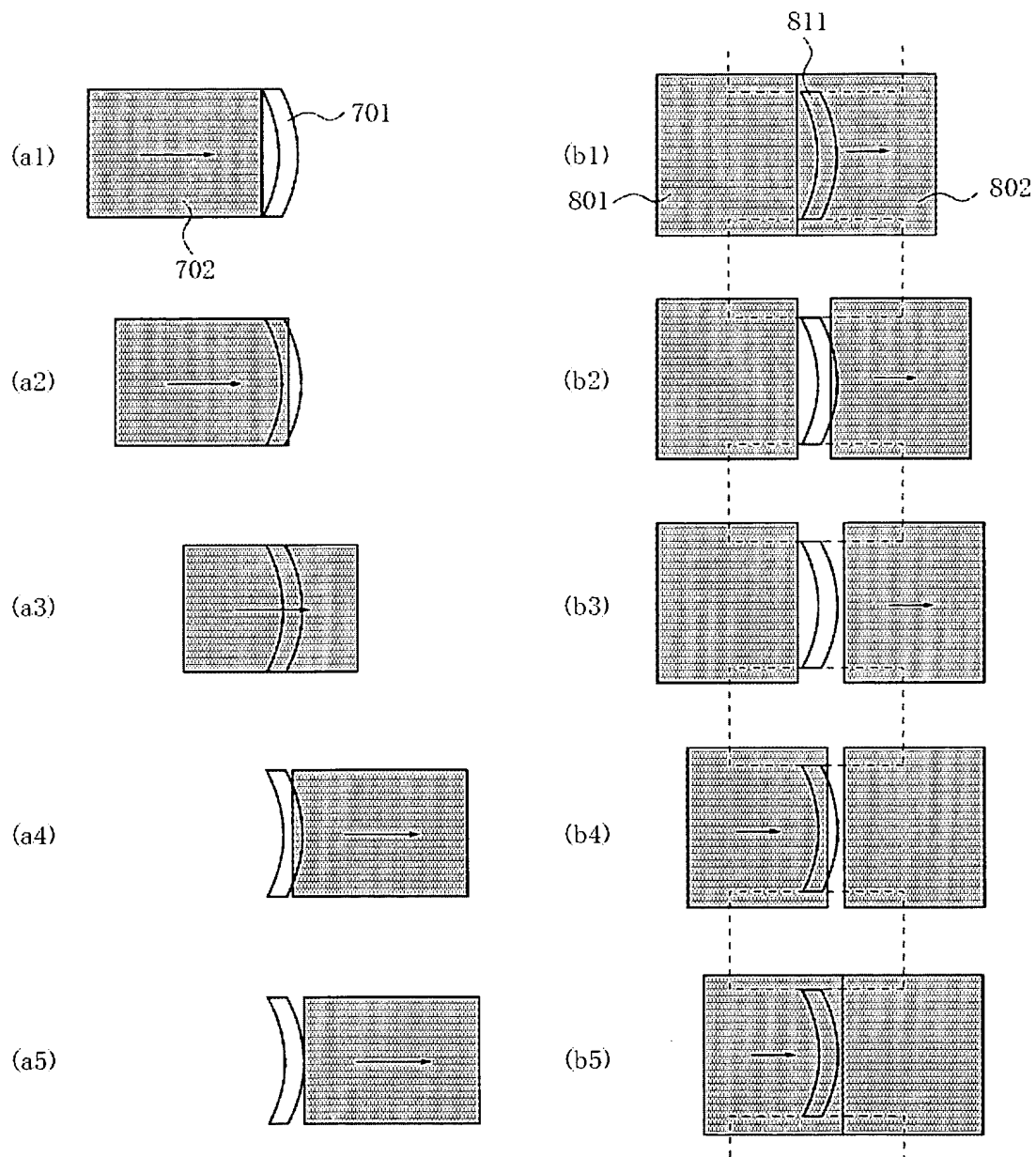
【図 7】



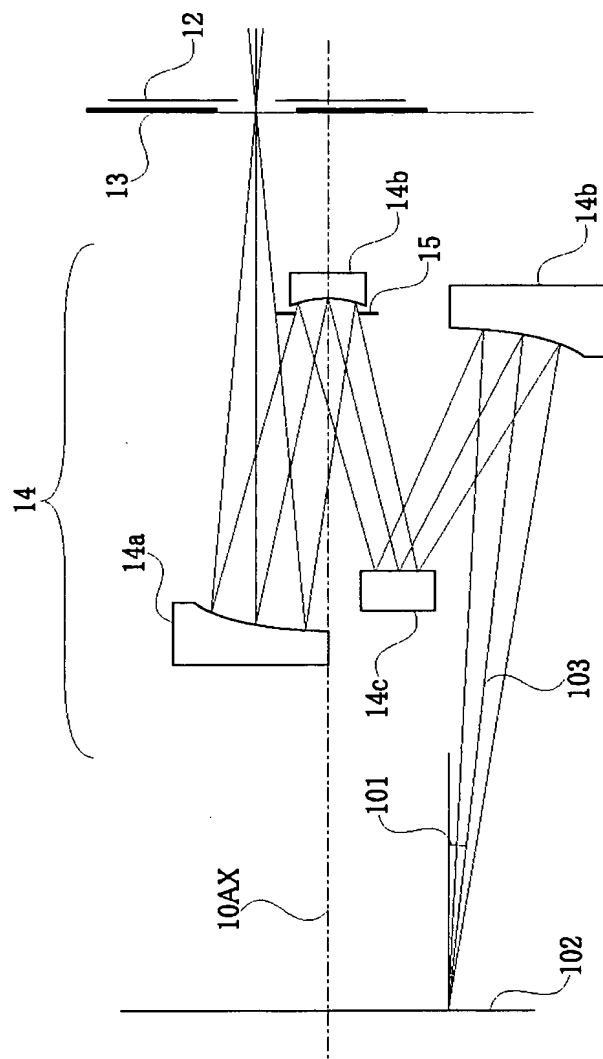
【図 8】



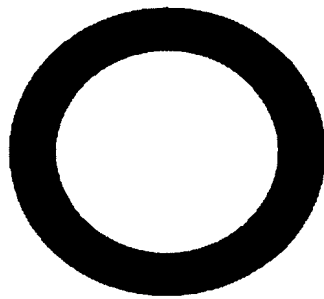
【図 9】



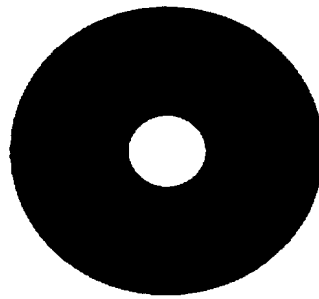
【図 10】



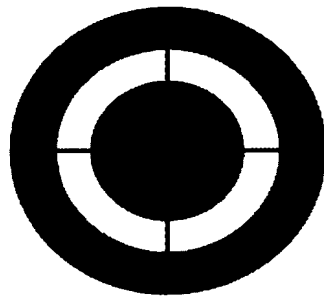
【図 1 1】



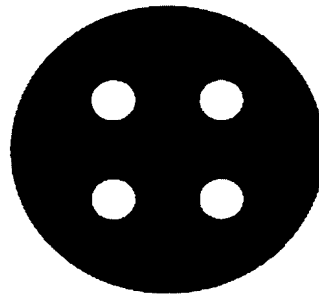
(a)



(b)

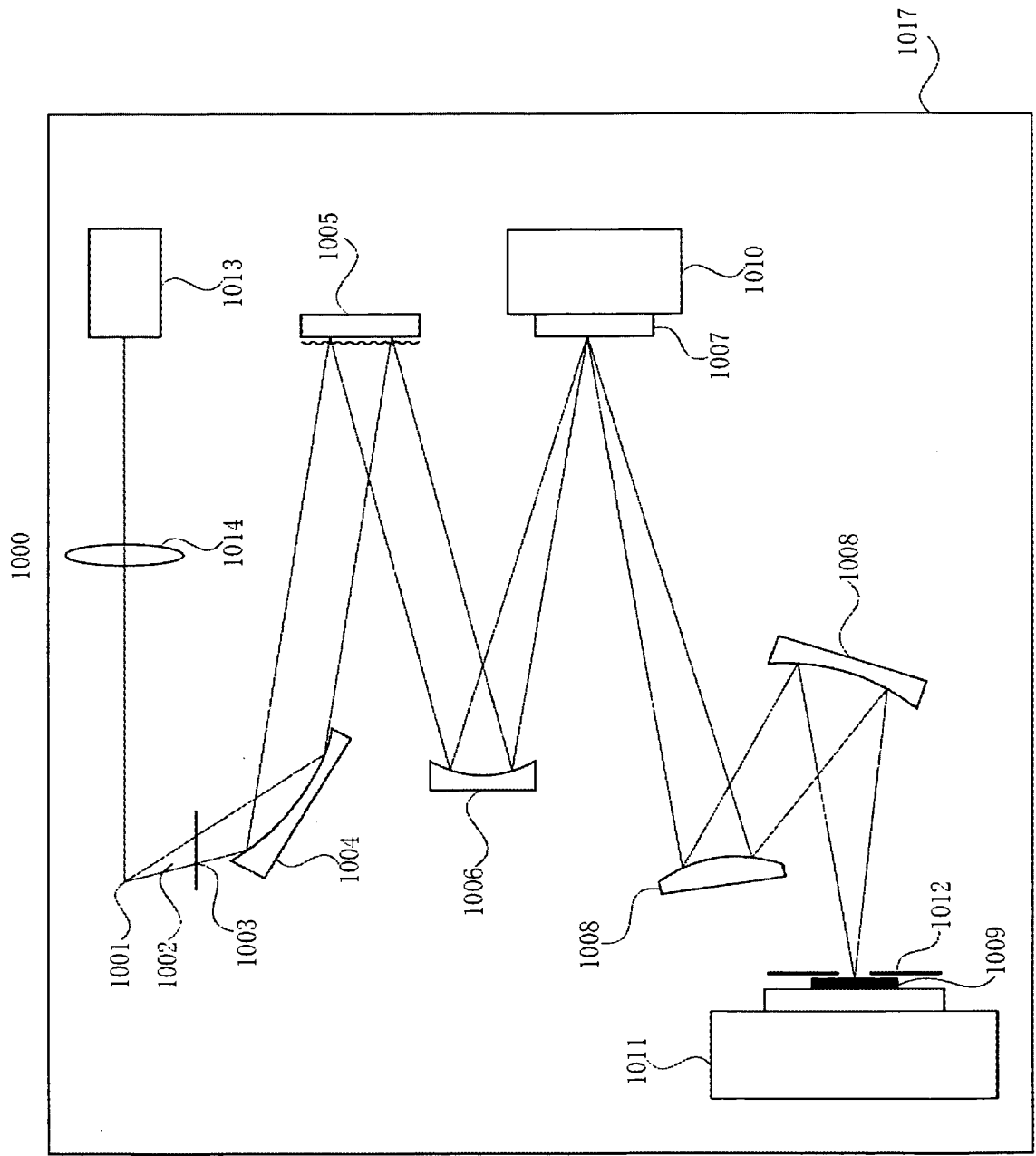


(c)

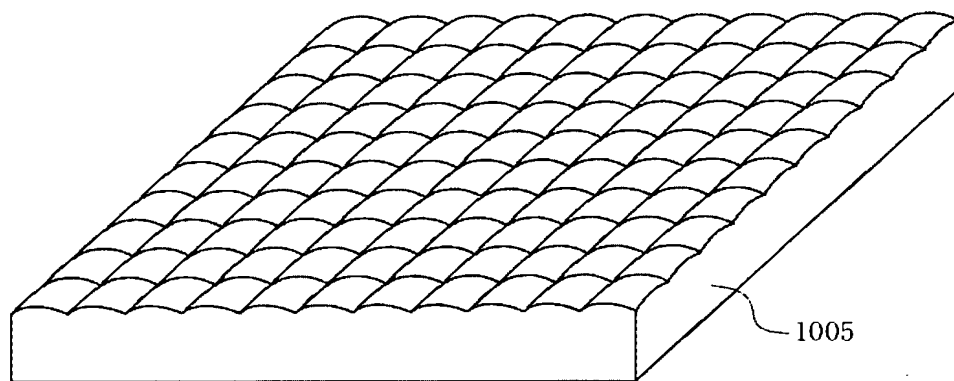


(d)

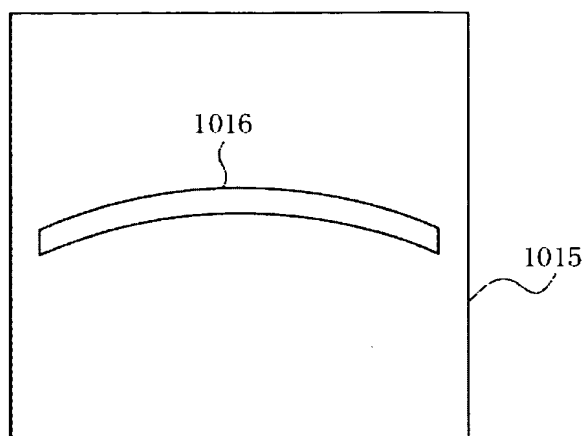
【図 12】



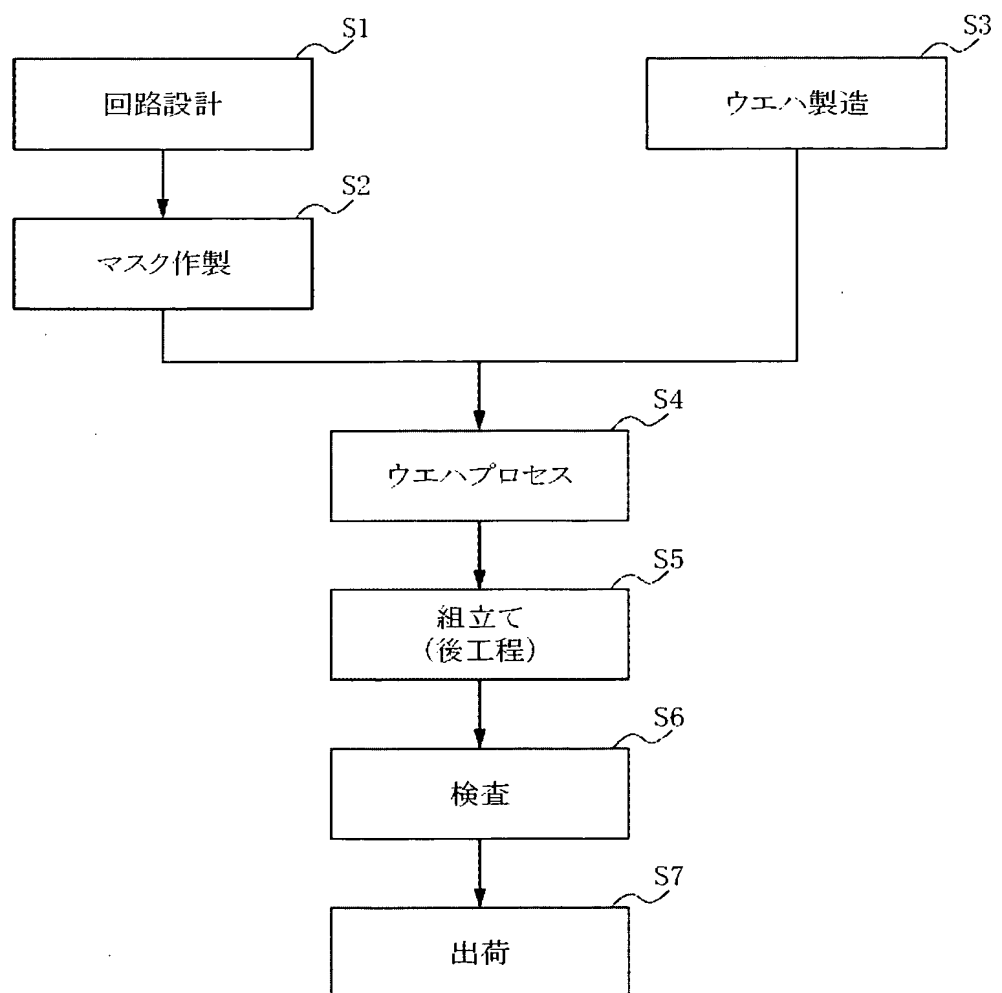
【図 13】



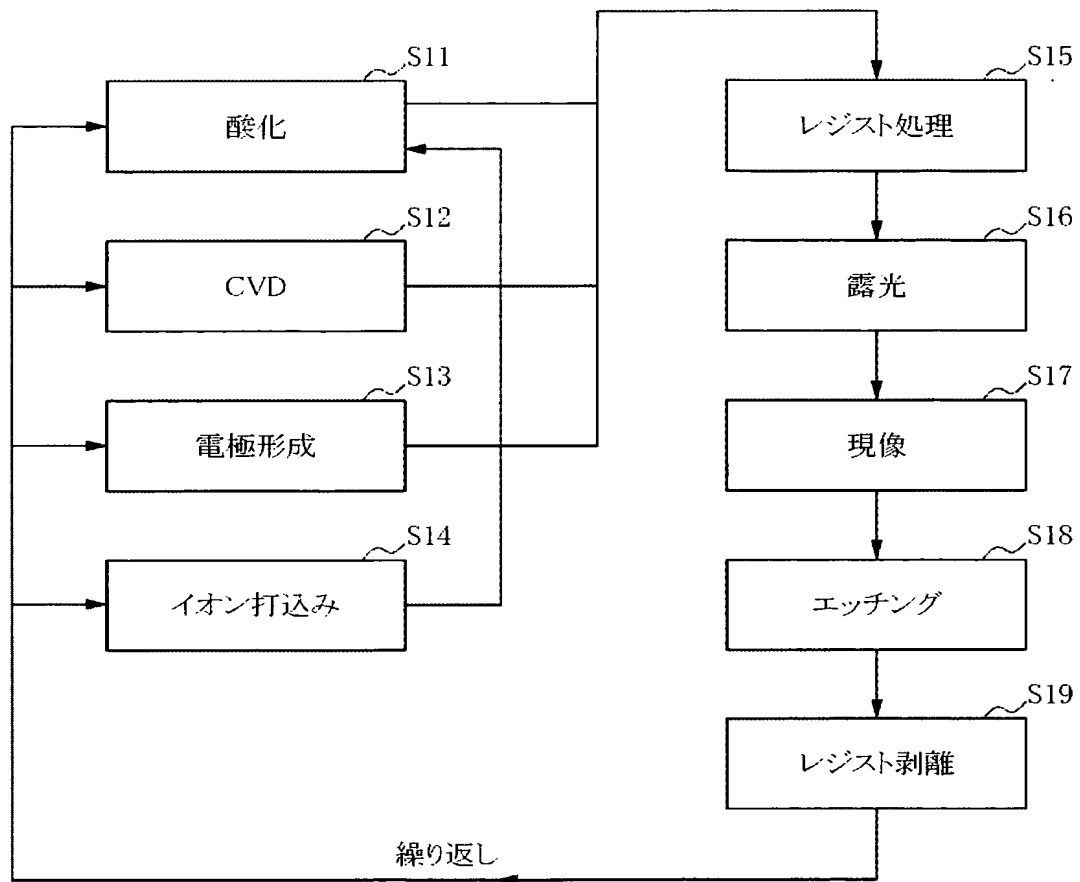
【図 1 4】



【図 15】



【図 16】



ウエハプロセス

【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 照明領域を規定するアパーチャとレチクルとの間の結像系の好適な構成を明らかにするとともに、その結像系を有する照明光学系を提供すること。

【解決手段】 光源からの光で反射型マスクを照明する照明光学系と、該反射型マスクのパターンを基板に投影する投影光学系とを有する露光装置において、前記照明光学系は、前記反射型マスクの照明領域を規定する視野絞りと、該視野絞りの開口からの光を前記反射型マスクに導く結像系とを有し、前記結像系は、共軸光学系であり、前記結像系の前記反射型マスク側の主光線は、該共軸に対して傾斜角を持ち、該傾斜角は、前記投影光学系の前記反射型マスク側の主光線と前記反射型マスクの表面の法線とがなす角に略等しいことを特徴とする構成とした。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 3 2 4 6 3 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名 キヤノン株式会社